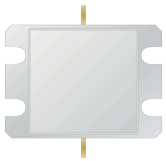
2700–3900 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 48.5 dBm (típico)

LCT-2700-3900-PS48p5T · 2700–3900 MHz · GaN Transistor de potencia con adaptación interna.



Valores de la tabla RF: PSAT 48.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 12.5 dB (típico); PAE 50 % (típico). Condiciones de ensayo RF: TA = +25 °C; VDS = 24–28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS.

CMW025B

Aplicar primero la polarización de puerta y después la de drenador. Al apagar, retirar primero la de drenador.

Los puertos RF requieren condensadores externos de bloqueo DC.

Dimensiones del encapsulado: 24.2 × 17.4 mm.

Características RF

TA = +25 °C; VDS = 24–28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	f	2700	-	3900	MHz
Potencia de salida saturada	-	48	48.5	-	dBm
Ganancia de potencia	-	12	12.5	-	dB
Eficiencia de potencia añadida	-	45	50	-	%
Planitud de la ganancia de potencia	-	-	-	1.5	dB

Polarización DC y corrientes

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Tensión de estrangulamiento	-	-4	-	-2	VDS = 6 V; IDS ≤ 80 mA	V
Corriente inversa de puerta	-	-	-	0.01	VDS = 0 V; VGS = -10 V	A
Tensión de drenador en funcionamiento	-	-	-	-	24–28	V
Tensión de puerta en funcionamiento	-	-	-	-	[-4, -2]	V

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión drenador-fuente máxima	-	-	-	60	V
Polarización de puerta mínima	-	-5	-	-	V
Temperatura de almacenamiento	-	-65	-	175	°C
Temperatura máxima del canal	-	-	-	200	°C

Dimensiones del encapsulado

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del encapsulado	24.2 × 17.4	mm
Dimensiones del encapsulado (H)	-	mm

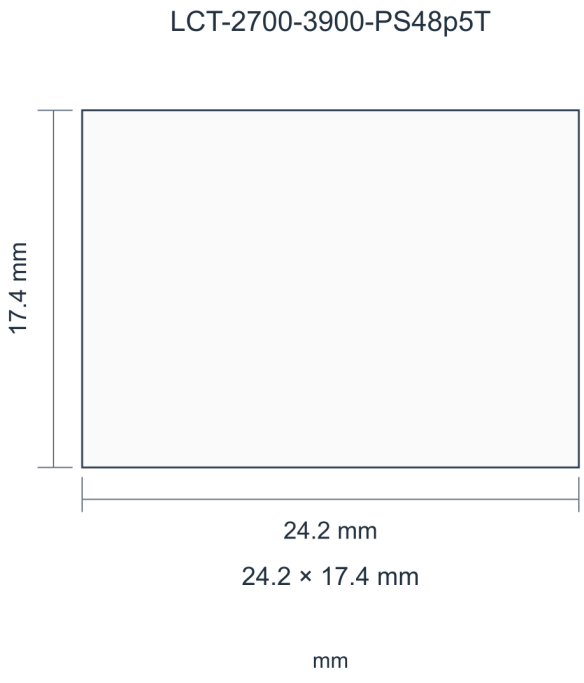
Registro de la publicación actual · 1.6 · 2026-11-12. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.5.

Notas de integración

CMW025B Aplicar primero la polarización de puerta y después la de drenador. Al apagar, retirar primero la de drenador. Los puertos RF requieren condensadores externos de bloqueo DC. G: Entrada RF D: Salida RF S: Fuente / tierra

Plano dimensional mecánico

Plano parcial con cotas confirmadas en mm. Para el montaje, consulte el plano completo de instalación.

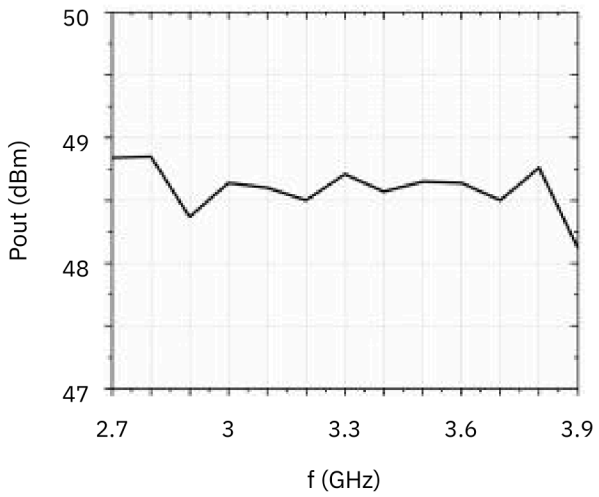


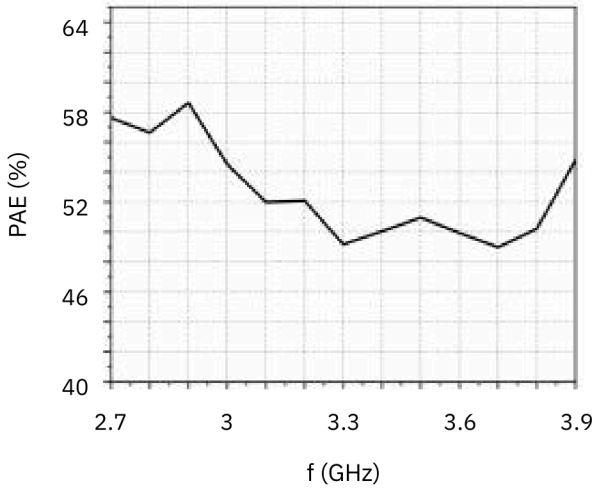
Curvas de rendimiento

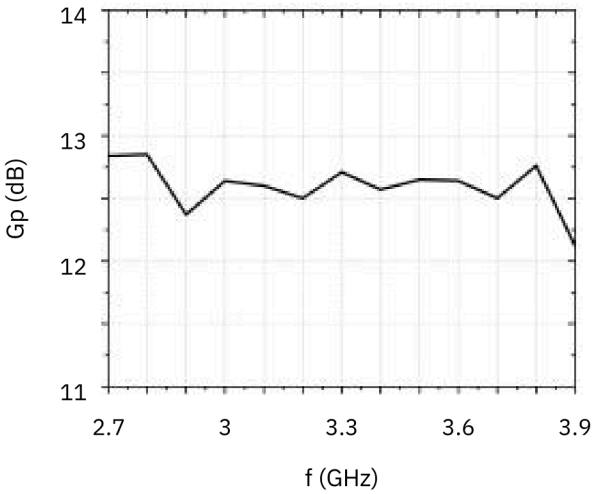
Cada gráfica de rendimiento corresponde a las condiciones de funcionamiento que indica.

Onda continua (CW) — Potencia de salida saturada; Eficiencia de potencia añadida; Ganancia de potencia.

Notas de la figura: Vd=+24V; Vg=-3.1V; Pin=36dBm.







Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.